

۴۴۳

۴۹۱

((I))

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ آموزش عالی
شورای عالی برنامه ریزی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس

دوره کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک



گروه فنی و مهندسی

تصویب سیصد و سی و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی

موافق ۱۳۷۵/۱۰/۲۳



برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد الکترونیک

کمیته تخصصی: برق
شاخص: کد رشته:

گروه: فنی و مهندسی
رشته: الکترونیک
دوره: کارشناسی ارشد

شورای عالی برنامه ریزی در سیصد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۳ بر اساس طرح دوره کارشناسی ارشد الکترونیک که توسط کمیته مهندسی برق گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی تهیه شده و به تائید این گروه رسیده است، برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) به شرح پیوست تصویب کرد و مقرر میدارد:

ماده ۱) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد الکترونیک از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند لازم الاجرا است.

الف: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و براساس قوانین، تأسیس می‌شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می‌باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می‌شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده ۲) از تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۳ کلیه دوره‌های آموزشی و برنامه‌های مشابه موسسات در زمینه کارشناسی ارشد الکترونیک در همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مذکور در ماده ۱ منسخ می‌شوند و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یادشده مطابق مقررات می‌توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند.

ماده ۳) مشخصات کلی و برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد الکترونیک در سه فصل جهت اجرا به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ می‌شود.

رأی صادره سیصد و سی و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۳
درخصوص برنامه آموزشی کارشناسی ارشد الکترونیک:

- (۱) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد الکترونیک که
ازطرف گروه فنی و مهندسی پیشنهاد
شده بود با اکثریت آراء به تصویب رسید.
(۲) این برنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

رأی صادره سیصد و سی و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۷۵/۱۰/۲۳ در
مورد برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک صحیح است
بمورد اجرا گذاشته شود.

دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

بمورد تائید است

دکتر علیرضا رهایی
رئیس گروه فنی و مهندسی

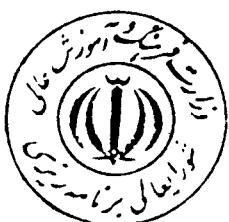
رونوشت: به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

سید محمد کاظم نائینی

دبیر شورای عالی برنامه ریزی



بسم الله الرحمن الرحيم



فصل اول

مشخصات دوره کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

(پژوهشی - آموزشی)

۱- تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد الکترونیک دوره‌ای است که مرکب از دروس نظری و بر مبنای تحقیقاتی در زمینه الکترونیک است. هدف از ایجاد این دوره تربیت کسانی است که با فعالیت در زمینه‌های برنامه‌ریزی، مدیریت، طرح و پیاده‌سازی شبکه‌های الکترونیکی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات الکترونیکی، بتوانند بنحو مؤثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند، فارغ التحصیلان این دوره می‌توانند علاوه بر کارآموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی و صنایع مخابراتی والکترونیکی، ارتش و سپاه، صدا و سیما و دیگر ارگانهای که در سطحی وسیع با مسائل الکترونیکی روبرو هستند، فعالیت نمایند.

۲- طول دوره و شکل نظام:

مدت این دوره حداقل ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دورس جبرانی نیستند چنانچه کاردرسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، قادرند باشد بتوانند در ۳ نیمسال این دوره را پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در ۴

نیمسال ارائه میشود زمان هر نیمسال ۱۷ هفته است و مدت تدریس بک واحد نظری ۱۷ ساعت میباشد.

۳- تعداد واحدهای درسی:

دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد الکترونیک باید حداقل ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیر را با موفقیت بگذراند.

اصلی تخصصی	۲۴ واحد
سمینار	۲ واحد
پروژه*	۶ واحد
جمع	۳۲ واحد

علاوه بر موارد فوق، هر دانشجوی این دوره در صورتی که فبلأ در دوره کارشناسی بالی انس، دروس جبرانی را نگذراند باشد، باید با حداقل معدل ۱۴ آنها را بگذراند برای دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمیگیرد.

۱-۳- دروس جبرانی

دروس زیرا ز دوره کارشناسی الکترونیک با نظر گروه آموزشی به عنوان دروس جبرانی این



* کبته تحصیلات تکمیلی دانشکده، (گروه آموزشی) مجری دوره می‌تواند در ازاً حذف بک درس اخباری سه واحدی نعداد واحد پروژه تحقیق را به ۹ واحد افزایش دهد.

دوره محسوب میشوند. دروس جبرانی عبارتند از

آزمایشگاه الکترونیک ۲

فیزیک الکترونیک

تکنیک پالس

آزمایشگاه تکنیک پالس

مدارهای مخابراتی

فیلتر و سنتز مدار

آزمایشگاه الکترونیک ۳

الکترونیک ۳



۴- شرایط گزینش:

۱-۴- دوره های کارشناسی پیشینیاز:

این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی «الکترونیک» برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر دوره های کارشناسی برق (مخابرات، قدرت، کنترل، سخت افزار کامپیوتر) و همچنین فارغ التحصیلان دوره های سابق مهندسی برق میتوانند در آن شرکت نمایند. مشروط بر آنکه دروس «جبرانی» تعیین شده را با معرفیت بگذرانند.

۲- علاوه برداشت شرایط عمومی مصوبه شورای عالی برنامه ریزی معدل دروس

تخصصی که دانشجو در دوره کارشناسی خود گذرانده است باید از ۱۲/۵ (۴ از ۵/۱۲)



بیشتر باشد.

۴-۳- آزمون ورودی: آزمون ورودی بطور کتبی از دروس پایه واصلی برق و تخصصی

الکترونیک بعمل می‌آید، لیکن بنحوی تنظیم می‌گردد که کسانیکه دورس تخصصی الکترونیک را

نگذراند، اند اما پایه قوی دریکی دیگر از دوره‌های کارشناسی برق (یادربه‌مندسی عمومی برق)

دارند، امکان موقتی در آن داشته باشند.

۴-۴- حداقل دروس جبرانی مورد نیاز: دانشجویی که به این دوره پذیرفته می‌شود باید

ناتواند از گذراندن بیش از یک ترم دروس جبرانی این دوره باشد (به قسمت ۳ مراجعه کنید).

۴-۵- دانستن یک زبان خارجی علمی: سلط بریک زبان خارجی علمی بنحوی که

دانشجو بتواند بسهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است. میزان این سلط

ممکن است بوسیله آزمون ورودی تعیین گردد.

۴-۶- مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صورت تشخیص ضرورت،

با کسانیکه درآزمون ورودی موفق شده‌اند، در مبنیه‌های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

دوره محسوب میشوند. دروس جبرانی عبارتند از

آزمایشگاه الکترونیک ۲

فیزیک الکترونیک

تکنیک پالس

آزمایشگاه تکنیک پالس

مدارهای مخابراتی

فیلتر و سنتز مدار

آزمایشگاه الکترونیک ۳

الکترونیک ۳



۴- شرایط گزینش:

۴-۱- دوره های کارشناسی پیشناخت:

این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی «الکترونیک»، برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر دوره های کارشناسی برق (مخابرات، قدرت، کنترل، سخت افزار کامپیوتر) و همچنین فارغ التحصیلان دوره های سابق مهندسی برق میتوانند در آن شرکت نمایند. مشروط بر آنکه دروس «جبرانی» تعیین شده را با موفقیت بگذرانند.

۴-۲- علاوه بر داشتن شرایط عمومی مصوبه شرایط عالی برنامه ریزی معدل دروس

تخصیص که دانشجو در دوره کارشناسی خود گذرانده است باید از ۱۲/۵ (۲/۵ از ۴)



بیشتر بُشد.

۴-۳ - آزمون ورودی: آزمون ورودی بطریکی از دروس پایه واصلی برف و تخصصی

الکترونیک بعمل می‌آید، لیکن بنحوی تنظیم می‌گردد که کسانیکه دورس تخصصی الکترونیک را

نگذراند، نه اما پایه قوی دریکی دیگر از دوره‌های کارشناسی برف (پادربمندسی عمرانی برف)

دارند، امکان موقبیت در آن داشته باشند.

۴-۴ - حداکثر دروس جبرانی بمرد نیاز: دانشجویی که به این دوره پذیرفته می‌شود نباید

ناتچار از گذراندن بیش از یک نرم دروس جبرانی این دوره باشد (به فصل ۳ مراجعه کنید).

۴-۵ - دانستن یک زبان خارجی علمی: سلط بریک زبان خارجی علمی بنحوی که

دانشجو بتواند بسهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است. میزان این سلط

ممکن است بوسیله آزمون ورودی تعیین گردد.

۴-۶ - مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صرارت تشخیص ضرورت،

با کسانیکه در آزمون ورودی موفق شده‌اند، در زمینه‌های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

فصل دوم



برنامه

برنامه‌های آموزشی و پژوهشی:

۱- دروس اصلی: هر دانشجو باید ۹ واحد از دروس اصلی (۳ درس از ۴ درس از جدول زیر) را بگذراند

شماره	نام درس	تعداد واحد
۱	طراحی مدارهای مجتمع خطی	۳
۲	کوانتم الکترونیک I یا ادوات نیمه‌هادی‌های I	۳
۳	طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا)	۳
۴	تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه‌هادی I	۳

دانشگاه‌های مجری دوره می‌توانند مجموعه‌های دروس کارشناسی ارشد مشابه تهیه نمایند

نادر صورت تأیید کمیته برق شورای عالی برنامه‌ریزی، در آن دانشگاه به اجرا درآورند

۲- دروس تخصصی اختیاری: دانشجو باقیمانده واحد‌های درس خود را باموافقت استاد راهنمای و کمیته تحصیلات تکمیلی از لیست دروس تخصصی و اختیاری گرایش خود و حداکثر تا دو درس از دروس اصلی و تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد سایر گرایشهای برق و دیگر رشته‌ها اخذ نماید.

جدول دروس تخصصی و اختیاری کارشناسی ارشد الکترونیک

تعداد واحد	نام درس
۳	ادوات نیمه‌هادی I
۳	الکترونیک نوری I
۳	ابر رسانانی I
۳	ادوات نیمه‌هادی II
۳	بررسی و کاربرد سیستم‌های موزایی
۳	بکارگیری قابلیت‌های مدارهای VLSI در طراحی مدارهای ویژه
۳	پردازش سیگنالهای دیجیتال
۳	ثئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه‌هادی I
۳	ثئوری و تکنولوژی ساخت عناظر و فطعات نیمه‌هادی II
۳	ریاضیات مهندسی پیشرفته
۳	طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا)
۳	طراحی مدارهای مجتمع خطی
۳	طراحی مدارها و شبکه بیاری کامپیوتر
۳	طراحی مدارهای VLSI
۳	کوانتم الکترونیک I
۳	کوانتم الکترونیک II
۳	کاربرد میکروپرورها و سیستم‌های کامپیون در صنعت
۳	مدارهای واسطه
۳	میکروپرور II (میکروپرور پیشرفته)
۳	مباحث ویژه در الکترونیک I
۳	مباحث ویژه در الکترونیک II

۳- سمینار:

گذراندن سمینار الکترونیک برای هر دانشجوی دوره اجباری است.

این سمینار شامل فرمتهای زیر میباشد:



معرفی زمینه‌های تحقیقاتی جاری، مشکلات و مسائل کشور در زمینه الکترونیک
معرفی زمینه‌های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پژوهه خود را از میان آنها برگزینند.
تهیه یک گزارش مدون وارائه آن در یک سمینار توسط هر دانشجو.

۴- پژوهه تحقیق (پایان نامه):

فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجو درجهت انجام یک پژوهه مشخص به ارزش ۶ واحد و در صورت طولانی بودن انجام پژوهه ۹ واحد خواهد بود. همچنین شرکت در کلاس‌های درسی دیگری که دانشجو برای انجام پژوهه خود نیازمند آن است ضروری می‌باشد.

۱- تصویب موضوعات پژوهه:

بمنظور آنکه موضوعات پژوهه‌ها درجهت رفع نیازهای کشور در زمینه‌های مسائل الکترونیکی فرارگیرد و در عین حال در تعیین آنها نوعی عمل زدگی بوجود نباید و آینده نگری ملحوظ داشته باشد. لازم است کمیته تخصصی با ترکیب مناسب عهده‌دار بررسی موضوعات پیشنهادی (از طرف اساتید، ارگانهای اجرائی و دانشجویان) و تعیین موضوعات مناسب برای پژوهه تحقیق باشد. در این بررسی ممکن است در مورد هر پژوهه، «اهداف و نتایج»، «وسائل لازم برای انجام کار»، «بودجه لازم» و «حجم کلی کار لازم»، بعنوان پرامترهای مهم مورد ارزیابی فرارگیرد.

نام درس	کد درس	ساعت			تعداد واحد
		عملی	نظری	جمع	
الكترونيک نوری II					۳
نور غیرخطی					۳
بردازش نوری تصاویر و علائم					۳
الكترونيک نوری کوانتومی					۳

۴-۲- ارزیابی و تصویب پروژه:

به همین ترتیب لازم است کمیسیونی عهده دار ارزیابی فعالیت دانشجو در پروژه کارشناسی ارشد از نظر «کمیت» و «کیفیت» باشد. قبول فعالیت تحقیقی دانشجو در دوره، موكول به تائید این کمیسیون خواهد بود.

بمنظور حفظ استاندارد وضوابط حداقل درپروژه‌ها دوره کارشناسی ارشد الکترونیک و جلوگیری از تاثیر سلیقه‌های فردی و پائین آمدن تدریجی سطح کار لازم است ترکیب این کمیسیون با توجه به ضوابط مناسب و بادقت کافی تعیین گردد.



تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشنباز:

سرفصل دروس: (۵۱ ساعت)

۱- رشدبلور و تهیه، ویفر

۲- دیفیوزن

۳- اکسیداسیون

۴- کاشتیون

۵- روش‌های گوناگون لیتوگرافی (شامل انواع Etching)

عمرشده‌های رونشستی (Epitaxy)

۶- روش‌های گوناگون نشاندن لایه‌های فلزی

۷- روش‌های گوناگون نشاندن لایه‌های دی الکتریک و Poly - Si

۸- فرآیند ساخت ادوات غیرفعال

۹- فرآیند ساخت ترازیستورهای دوقطبی

۱۰- فرآیند ساخت ترازیستورهای اثرمیدانی

۱۱- روش‌های گوناگون اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی در تکنولوژی

مراجع:

۱- کتاب فیزیک الکترونیک و تکنولوژی نیمه‌هادیها، اکبر ادبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۲۵

1) VLSI Technology, by S.M.sze , second Ed/McGraw - Hill 1990

2) Microelectronic Processing and Device Design, by C.Ruska & M. Mcgrawhill, 1982

3) Introduction to microelectronic fabrication/by : Jaeger , Addison-Wesley , 1985

تئوری و تکنولوژی II

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشنبه: تئوری و تکنولوژی I



سrfصل درس: (۵۱ ساعت)

۱- رشدبلور گالیوم آرسناید - گالیوم آلمینیوم آرسناید.....

۲- نحوه افزایش ناخالصی هادر گالیوم آرسناید

۳- سیستم MBE (رشد توسط اشعه ملکولی)

۴- بررسی طراحی و ساخت

۵- نحوه، انجام فلزکاری بر عناصر و مدار ساخته شده با گالیوم آرسناید

۶- بررسی طراحی و ساخت ادوات تناهمگون با گالیوم آرسناید و گالیوم آلمینیوم آرسناید

۷- بررسی طراحی و ساخت ترانزیستورهای با قابلیت تحرک بالا (HEMT)

۸- بررسی نحوه ساخت ترانزیستورهای HBT

۹- تکنولوژی ادوات ساخته شده با ابر شبکه ها

۱۰- تکنولوژی ساخت لینزهای نیمه هادی و Array

مراجع - بعلت پیشرفت سریع در تکنولوژی وايجاد تحول و دگرگونی در روش های ساخت مخصوصا "در رابطه با ادوات نیمه هادی جديدهتر است به مقالات منتشره در تکنولوژي مراجعه نمود.

کوانتم الکترونیک I

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشنبه: نه



سرفصل دروس (۵۲ ساعت)

- دلایل ایجاد مکانیک کوانتمی (منشاء تاریخی نظریه کوانتمی)
- مبانی مکانیک موجی برای ذره آزاد (خامیت موجی ذرات مادی - توابع موج ذره آزاد حل معادله شرودینگر - برهم نسبی امواج تخت - انتگرال فوریه - اصل عدم قطعیت برای بسته موج عدم قطعیت مکان - مومنتم و زمان - انرژی - بسته موج گو -)
- احتمال و ارزش انتظاری یک کمیت دینامیکی مشاهده پذیر در مکانیک کوانتمی)
- عملگرها (operators) - اصول اساسی مکانیک کوانتمی - مقدمه ای بر نظریه اختلال - ساختار بلوری - ارتعاشات شبکه بلوری - الکترون آزاد - ساختار باند انرژی سطوح فرعی در فلزات - بررسی حرکت حامله دار نیمه هادیها - قابلیت تحرک -

مراجع -

- ۱- مکانیک کوانتمی تالیف جان . ل . پاول و برندکریسمان ترجمه جلال الدین پاشائی راد و عبدالرؤف اسعادت
- ۲- فیزیک کوانتمی تالیف استفان گاسیوروچ ترجمه جمیل آریائی و محمدرضا مطلوب
3 - understanding Quantum Physics , Morrison , M.
4 - Introduction to Quantum mechanics , Liboff , L.

آشنائی با فیزیک حالت جامد، نوشته - چناوکز کیتل
ترجمه - اعظم پور قاضی ، مهدی صفا ، جمشید عمیقیان

کوانتم کترونیک II

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشیاز: کوانتم کترونیک I

سفرصل دروس: (۵۷ ساعت)

- دینامیک سیستم‌های کوانتمی

- دینامیک کریستال (امواج شبکه و فنونها و طول عمر آنها - گرمای ویژه، شبکه)

- نظریه اختلال (مستقل از زمان ووابسته به زمان)

- ساختار باند الکترونی (مدل‌های مختلف ساختار باند - تئوری مقیاس‌گیری تابع
دی الکتریک برای ساختار باند - آلیاژ‌های نیمه‌هادی نظیر InGaAs و یا AlGaAs
و ساختار باند در آنها - ساختار باند در اتصالات ناهمگون)

- نظریه پراکندگی

- اثر متفاصل الکترون و فنون - معادله بولتزمن برای انتقال الکترون در کریستال انتقال
جذب و بازترکیب حامله‌ادر کریستال

- اثرات میدان بزرگ در هدایت (اثبات سرعت و انتقال گذرا، روش مونت‌کارلو برای حل
معادله بولتزمن، یونیزاپیون با برخورد، پراکندگی بین دودره و اثر Gun، برخورد های
بین الکترون ها و اثبات این ذر توزیع حامله‌ادر میدان بزرگ)

مراجع -

- 1- semiconductors , D.K. Ferry
- 2- Physics of semiconductors and their hetero structures , Singh J
- 3- physical properties of III - V semiconductor compounds , Adachi A.
- 4- physics of semiconductor Devices, D.K. Ferry
- 5- Advanced theory of semiconductor Devices, Hess , Karl
- 6- Montecarlo Device simulation, Hess , Karl

ادوات نیمه‌هادی II

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشنبه: ادوات نیمه‌هادی I



سrfصل دروس: (۵۲ ساعت)

۱- بررسی مشکلات و محدودیت‌های طراحی ترانزیستور با استفاده از اتمالات همگن

۲- بررسی تئوری اتمال ناهمگون

۳- ترانزیستور دوقطبی با استفاده از اتمال ناهمگون (H.B.T)

۴- بررسی تئوری ترانزیستور‌های یا قابلیت حرکت بالا (نظریه HEMT از گالیوم آرسناید)

۵- تئوری ساختار ابرشبکه‌ها

۶- تئوری قطعات الکترونیکی با استفاده از اثر تونلزنی در ابعاد میکروسکوپی

(Resonant tunneling Devies)

مراجع

1- Physics of submicron Devices . . . D.K. Ferry, Rezonans 1991

2- Relevant Papers.

فیزیک الکترونیک و تکنولوژی نیمه‌هادیها . تالیف دکترا کبرادیبی . ۴۲۵

انتشارات دانشگاه منطقی امیرکبیر

الكترونیک نوری (I)

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : تئوری

پیشناز : الکترومغناطیس

هم نیاز :

سفرصل دروس : (ساعت)

۱- مروری بر تئوریهای کلاسیک و مدرن

- نظریه الکترو مغناطیس

- قوانین انکسار و انعکاس نور (معادلات فرنل و اسنل)

- اثر فتو الکتریک

- تئوری پاشندگی

- ساختمان کریستالی نیمه هادیها

- تئوری تابش جسم سیاه

- نظریه کوانتم مکانیک و تئوری باند، مفهوم جرم موثر و دانسیته حالتها

۲- سیستمهای فیبر نوری

- نور هندسی و طبقه بنده فیبرهای نوری

- آنالیز یک فیبر نوری از دیدگاه موج

- موج برها مسطح دی الکتریک

۳- منابع نوری تکرنگ (لیزر)

- انواع برهم کنش نورو ماده

- معادلات انسیستین ، پدیده وارونگی

- انواع پمپینگ و معادلات نرخ

- محاسبات ضریب جذب

- طرز کار فبری پرو

- انواع لیزر



۴- منابع نوری تکرنگ (دیودنوری)

- طرز ساخت دیودهای نوری L.E.D

- کوپلینگ نوری از تئید به فیبر

- ویژگیهای دیودهای نوری از نظر پاسخ فرکانسی و مدولاسیون

- توان خروجی و عمر مفید

۵- تقویت کننده های نوری

- نوع فبری پرو

- نوع موج رونده

- معادلات تقویت کنندگی سیگنال کوچک

۶- صفحات نمایش نوری

- اثر لومینانس و فسفرسانس

- صفحات اشعه کاتدی CRT

- صفحات پلاسما

- صفحات نمایش کریستال مایع LCD

۷- آشکار سازهای نوری

- فتو دیودهای p-n

 p-i-n " -

 APD " -

- فتوترانزیستورها

۸- ملاحظات نویز

- نویز حرارتی ، تاریکی ، کوانتم

- نویز در علائم آنالوگ و دیجیتال

- نویز در آشکار سازهای نوری



- مدولاسیون نوری ۹

- قطبش نور

- مفهوم دوشکستی

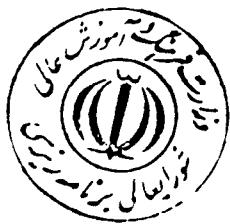
- اثرات الکترواپتیک Pockels و kerr

- چرخش فارادی و مدلسیون مگنتواپتیک

- شرط پراش برآگ

- اثراکوستواپتیک

- چند مثال کاربردی دزمنوردمدولاسیون نوری



منابع و مراجع

1. J.Wilson, Hawkes, Optoelectronics, 1983 .
2. A. yariv, quantum electronics, 1989 .
3. A. yariv , Intr. to optical electronics, 1976 .
4. J.M. senior, optical Fiber com. , 1985
5. wim van Etten, Fund. of optical Fiber com. , 1991 .
6. Pierret, Advanced semiconductor Fund., 1987 .
7. J.Wilson, Hawkes, Laser principles, 1987 .
6. Hecht E. , Optics, 1987 .

الکترونیک نوری (II)

تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوری

پیشنباز : الکترونیک نوری (I)

صرفه دروس : (ساعت)

۱- لیزرهای نیمه هادی

- مکانیزم نوسان لیزر نیمه هادی

- متدهای مدولاسیون و دمودولاسیون نوری

- PLL نوری، (هترودین و همودین)

- کاربرد لیزرهای نیمه هادی در مخابرات

- " " " در اندازه‌گیری

- " " " در میکروسکوپی STM

- طیف نگاری و پمپینگ نوری ساعتها اتمی

- لیزرهای قابل تنظیم (tunable)

- لیزرهای با طول موج کوتاه

۲- خواص مواد (photorefractive)

- خواص مواد فروالکتریک

- مفهوم پلاریزاسیون الکترونیک مواد در باند نوری

- شناسایی موادی که ضریب انكسار آنها مطابق تغییرات نور عوض می‌شود.

۳- نور غیر خطی

الف) اثرات غیر خطی نور در محیط غیر ثابت

- حل معادله موج در محیط بادی الکتریک غیر خطی

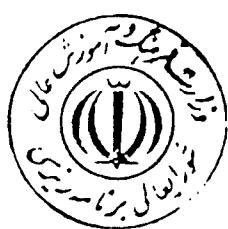
- تansور پذیرفتازی غیر خطی

- تولید هارمونیکهای دوم و بالاتر فرکانسی

- پدیده دوشکتی و پدیده تطبیق فاز در مواد دو شکستی

- یکسازی نوری

- مخلوط سازی نوری



- تقویت کننده ها و نوسانگرهای پارامتری

ب) اثرات غیر خطی نوری در محیط‌های فعال

- بررسی پدیده پراکندگی بریلوئین برانگیخته S.B.S.

- بررسی " " رامان " S.R.S.

- پدیده مزدوج فاز به دو روش S.B.S. و مخلوط‌سازی چهارموج FWM

- سولیتونها و تحلیل تئوریک انتشار آنها

۴- کامپیوترها و ادوات پردازش نوری اطلاعات

- مروری بر نور فوریه و تبدیلات فضایی

- تئوری انگرال کیرسف و زومر فیلد

- پراش فرنزل و فرانهوفر

- خواص تبدیل فوریه عدیها

- فیلترهای فضایی و ندرلوگ

- کوریلیتورهای نوری

- هالوگرافی

۵- مدارهای مجتمع نوری

- هدف از ساخت O.I.C.

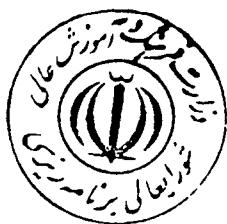
- قطعات مجتمع شکافنده ها و کوپلهای نوری

سوئیچهای و مدولاتورهای نوری

- مواد سازنده مدارهای مجتمع نوری O.I.C.

- موارد کاربرد ادوات مجتمع فتوئیک ، بررسی چگونگی ساخت سیستم‌های تمام‌نوری

- طرز ساخت گیتهای منطقی و فلیپ فلاپهای نوری



۶- روند آتی پیشرفت

- میکروسکوپهای STM

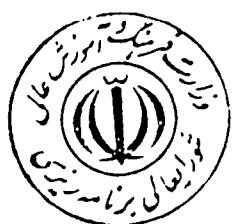
- آشکارسازی امواج جاذبه‌ای

Sagnac - زیروسکوپهای لیزری و اثر

- زیروسکوپهای فیبر نوری

LIDAR -

- پمپینگ نوری ساعتهاي دقیق اتمی



مراجع :

1. M. Ohtsu, Highly coherent semiconductor lasers, 1991
2. A. yariv, Quantum electronics, 1989
3. G. Baldwin, Nonlinear optics, 1975
4. K. preston, coherent optical computers, 1972
5. J. Goodman, Fourier optics, 1968
6. M. A. Omar, Elementary Solid-state physics, 1974
7. S. Wang, Fundamentals of semiconductor Theory & Device physics, 1989
8. J. T. Verdegen, laser electronics, 1989
9. Saleh, Fundamentals of Photonics, 1991

نور غیر خطی

تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوری

پیشیاز :

سر فصل دروس (ساعت)

- مقدمات و کلیات

- بررسی اثرات خطی و غیر خطی در نورشناخت
- تئوری میدان (الکترومغناطیس) در نورشناخت
- اپیتک هندسی
- تئوری کوانتم در توجیه فرآیند انتشار
- بررسی خواص نوری در محیط تحت تابش نور
- پاشندگی

- پراکندگی Rayleigh

- اثر Debye-sears

- مفهوم دو شکستی

- اثرات Stark و Zeeman

- اثرات پیزوالکتریسیته

- مفهوم فعالیت نوری ماده

- اثرات مکنتواپتیک

- اثر رامان و بربلوئین

- اثرات غیر خطی نوری در محیط غیر فعال

- روش‌های حل معادله موج در محیط با دی الکتریک غیر خطی

- تانسور پذیرفشاری غیر خطی

- تولید هارمونیک دوم فرکانسی

- پدیده تطبیق فاز در مواد دو شکستی

- تولید هارمونیک‌های بالاتر از هارمونیک دوم





- عمل پکسوسازی نوری
- عمل مخلوط سازی نوری
- تقویت کننده ها و نوسانگرهای پارامتری
- پدیده: مزدوج فاز
- اثرات غیر خطی نوری در محیط‌های فعال
- بررسی پدیده، پراکندگی رامان برانگیخته S.R.S
- بررسی پدیده، پراکندگی بریلوئین برانگیخته S.B.S.
- تولید موج مزدوج به روش مخلوط سازی ۴ موج ۴W
- رفتارهای غیر خطی در گازها
- بررسی چگونگی تولید سولیتون Soliton

- 1- Nonlinear Optics , G. Baldwin , Plenum Press 1975
- 2- Quantum electronics, A. yariv ^{and} , Johnwiley sons, 1986
- 3- Nonlinear Optics , N.Bloembergen

تعداد واحد: ۳

نوع واحد : تئوری - مقدمات و کلیاتی

پیش‌نیاز :

سرفصل دروس: (ساعت) - تحلیل حوزه فرکانس فضایی

- فیلترینگ فضایی در حوزه فرکانس فضایی

- فیلترهای تطبیقی فضایی

- انجام عملیات تابع همبستگی فضایی

- تحلیل تبدیل فوریه فضایی در دو بعد

- تئوری نمونه برداری در دو بعد فضا

- اصول تئوری پراش

- فرمول بندی کیرشف از پدیده پراش

- فرمول بندی ری - لی ، زومرفیلد از پدیده پراش

- پراش فرنل و فرانهوفر (همراه با مثال)

- پردازشگرهای نوری مجهر به سیستم عدسی

- خواص تبدیل فوریه عدسیها

- ساخت پردازشگرهای نوری بكمک عدسیها

- ریاضیات مربوط به محاسبات نوری

- روش‌های مدولاسیون (دامنه، فاز)

- اثرات پلاریزاسیون

- منابع نویز

- مدولاتورهای نوری فضایی (SLM) - طرز ساخت و عملکرد آنها

- ذرات معلق Silver halide و منابع نویز

- مواد فتوکرومیک (آلی و معدنی)

- شیشه‌های فتوکرومیک

- فیلم‌های ترمومپلاستیک

- اثرات فارادی و Kerr , Pockels

- مدولاتورهای فضایی LCD

- مدولاتورهای فضایی موج مسطح اکوستیکی



-روش‌های محاسبات نوری دیجیتال

-اصول هالوگرافی

-محاسبات اصلی نوری (جمع، تفریق و ضرب)

-موارد کاربرد

Phased - array Beam formiy

Synthetic - aperture . Techmiques

Freq,Multiplexed Television

Homodyne correlator

2-D correlation det.

O. Pattern Recognition , Hybrid computers



منابع و مراجع :

1- Coherent optical computers, kendall preston ,1972

" Fourier optics, J. Goodman ,1968

3- Optoelectrenics, wilson,Hawkes,1983

4-Optical Signal Processing, Compating..., T. S. yu , 1992

الکترونیک نوری کوانتومی

تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوری

پیشنباز :

سر فصل دروس : (۵۲ ساعت)



- مروری بر کوانتوم مکانیک (کوانتوم مکانیک فوتون)

(مکانیک ها میلیونی - اپراتورها و بردارهای حالت - کوانتیزه کردن اسیلاتورهارمونیک)

- کوانتیزه کردن میدان

(کوانتیزه کردن میدان های الکترومغناطیسی Transverse - فتون - فنون های شبکه خطی - فنون های شبکه ۳ بعدی)

- اثر متقابل بین بارها و میدان ها - صدور فتون بوسیله الکترون آزاد

- اثر متقابل الکترون های درگیر (Bound) و شاع نور (صدور تصادفی صدور تحريك شده و جذب توسط الکترونهای درگیر ، Maser یک بعدی ، تداخل لیزر، اثر دوپل...)

- نویز و شمارش آماری (نویز حرارتی ، کوانتومی ، shot Noise ، توزیع پواسون شمارش آماری فتون)

- ماتریس غلط (تعریف و خاصیت آن، بررسی خواص لیزر با ماتریس غلط اشباع لیزر، بررسی اثرات غیر خطی با استفاده از ماتریس علظت ، تولیدهارمونیک دوم ، اثر رامان...)

- بررسی تلفات (اسیلاتورهارمونیک میرا و هامیلتونین آن مدھای مختلف در حفظ تلفات دار ، نویز حرارتی و مدل تلفات)

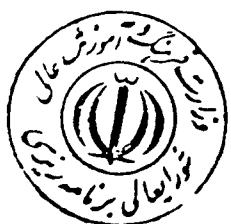
- اثر متقابل همدوس (coherent Interactions) بین میدان یک شاع نور و یک سیستم اتمی (بررسی برداری اثر - سوبر رادیانس - اکوهای فتون ترانسپرنسی مربوط به القاء خودی)

- فنون ها (فنون های صوتی و نوری)

منابع و مراجع

مراجع:

- 1- Engineering Quantum electrodynamics by D. marcuse
Harcourt, Brace and world Inc. 1970
- 2- Yariv A. , Quantum electronics, by John Wiley & sons, 1989
- 3- Omar, M.A. , Elementary solid - state Physics, Addison-wesely,
1975
- 4- Yariv A, Introduction to Quantum Mechanics, 1982



"کاربر نمیکروپرسورها و سیستم‌های کامپیوتری در صنعت"

تعداد واحد: ۲

نوع واحد:

پیش‌نیاز:

کاربر دو سیع سیستم‌های کامپیوتری و PLC هادر صنعت و رشد روز افزون این تکنولوژی در دنیا از یک طرف و ضرورت تربیت دانشجویان بمنظور رفع مشکلات کشور از طرف دیگران گیزه اصلی، پیشنهاد این درس برای کارشناسی، ارشدمی باشد که در زیر رئوس مطالب درس ذکر گردیده است.

۱- سنسورها و مدارات واسطه‌آنها:

- انواع سنسورهای مورد استفاده در محیط‌های صنعتی.
- دقیق در سنسورها.
- چیزهای مهم مورد استفاده.
- مدارات واسطه سنسورها.



توضیح: برخی از اندازه‌گیری‌ها در محیط‌های صنعتی، بدلیل دقیق در اندازه‌گیری، نویز و محیط مورد استفاده از اهمیت خاصی برخوردار است بعنوان مثال اندازه‌گیری سطح مخازن بزرگ با دقیق یک پلیمتر؟ یا رطوبت‌نگاری و مطلق؟

۲- انتقال اطلاعات در محیط‌های صنعتی:

- بصورت آنالوگ (ولتاژی و جریانی).
- بصورت دیجیتال و با استفاده از میکروپرسور.

۳- نویز در محیط‌های صنعتی:

- انواع نویز در محیط‌های صنعتی (کوپلاز هدایتی، کوپلاز امیدانس مشترک، کوپلاز میدانی‌ای الکترونیکی و مغناطیسی).

- روش‌های حذف نویز (شیلد، فیلتر، فیلتر دیجیتال و....)؟

۴- قابلیت اطمینان در سیستم‌های کنترل:

- قابلیت اطمینان در اجزاء.

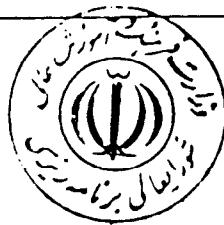
۵- قابلیت اطمینان در انتقال اطلاعات:

- قابلیت اطمینان در مجموعه سیستم کنترل (سطح کنترل،

.(SLAVES, MASTERS

۶- میکروکنترولرها:

- ویژگی‌های عمومی میکروکنترولرها.



- توضیح یک میکروکنترولر ۱۶ بیتی .

- یک مثال از طراحی سیستم با میکروکنترولر .

: (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) PLC^۶

- ویژگی‌های عمومی PLC ها و تفاوت آنها با کامپیوتر معمولی .

- توضیح یک PLC از نظر ساخت افزاری با امکان کنترل PID .

- زبان برنامه‌نویسی PLC ها و دیاگرام بریتانی (LADDER DIAGRAM) .

مراجع درس " کاربرد میکروبرو سورها و سیستم‌های کامپیوتری در صنعت "

1- Computer Controlled Systems

Karlj . Astrom, Printice - Hall, 1990

2- Programmable Logic controllers and Their Engineering Application, alan J.Crispin McGraw . Hill 1990

3- Programmable Controllers: Operation & Application Warnock , Ian G-Newyork, Prentice Hall 1992

4- Industrial Control Electronics, jacob, Prentice - Hall 1989

5- Transducer Interfacing Prentice Hall , 1988

بکارگیری قابلیت‌های مدارهای VLSI در طراحی مدارهای بزرگ

تعداد: ۳

نوع واحد:

پیش‌نیاز:

سrfصل دروس (۵۱ ساعت) ملاحظات تکنولوژیک، اتصالات و ورودی و خروجی، منظمهای تکرار پذیری، تفکیک به اجزاء، پایپ لاین و پردازش موازی، برنامه‌پذیر بودن، قابلیت تغییر ساختمان غیر حاسوبودن نسبت به بروز عیب، تفکیک مدار مجتمع به اجزا قابل کنترل، طراحی لایه‌ای و مرحله‌ای (Hierarchical)

- مروری بر قواعد روش‌های مهم پردازش سیگنال‌های دیتا و تصویر
- روش‌های تصویر قواعد ریاضی پردازش سیگنال بر روی ساختمانهایی از عناصر پردازشگر منظم موازی
- آرایه‌های پردازشگر ضربانی (Systolic Arrays)
- آرایه‌های پردازشگر موجی (Wavefront Arrays)
- مروری اجمالی بر روش‌های تحقق و ساخت آرایه‌های پردازشگر
- بررسی برخی کاربردهای از جمله طراحی آرایه‌های موازی برای تحقق شبکه‌های عصبی، پردازش تصویر تخمین‌طیف، فلیت‌رکالمن، شکل دهی به موج و آنالیز و سنتز مکالمات.

مراجع :

1-S.Y. Kung, " VLSI Array Processors," Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ, 1988.

2- Notes and Papers.



طراحی مدارهای VLSI



تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوری

پیشنباز :

سrfصل دروس : (۵۱ ساعت)

- مقدمه و مروری بر تاریخچه مدارهای مجتمع

- انواع متدهای انتگر کردن (Gate Arrays, semi-custom Full custom)

- مروری بر فیزیک ترانزیستورهای CMOS و تکنولوژی MOS

- مراحل مختلف فرآیند ساخت و نقش ماسکهای مختلف

- قوانین و روش‌های طراحی (CMOS Design Rules) در تکنولوژی CMOS

- مروری بر طراحی مدارهای دیجیتال در تکنولوژی CMOS و مقایسه مدارهای منطقی دینامیکی و استاتیکی

- معرفی مراحل مختلف طراحی در سطوح سیستم ، بلوک ، و گیت و ترانزیستور

- معرفی نرم افزارهای ابزار طراحی (CAD TOOLS) شامل نرم افزارهای شبیه‌سازی در سطوح مختلف سیستم ، گیت ، و ترانزیستور و نرم افزارهای تهیه لی‌آوت ، استخراج مداراز لی‌آوت و شبیه‌سازی دوباره و سایر نرم افزارهای جانبی نظیر :

Fault simulation, Timing analysis

- معرفی مسئله بازدهی تولید (yield) و آزمون مدارهای مجتمع

- معرفی و اجرای پروژه‌های کوچک نمونه جهت بکارگیری ابزارهای طراحی (مثال : طراحی یک ALU)

- توضیح : ارائه این درس لزوماً باید همراه با بکارگیری عملی بسته‌های نرم افزاری مربوطه باشد .

مراجع :

1- CMos vLst design, N. weste,K. Eshraghian, 1993

2- Introduction to vLst system , C. Mead, Conway

ادوات نیمه هادی I

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : تئوری

پیشنباز :

سرفصل دروس (ساعت)

۱- مروری بر مبانی فیزیکی پیوند n-P

۲- تئوری پیشرفت، ترانزیستورهای دو قطبی

۳- الگوهای گوناگون ترانزیستورهای دو قطبی

۴- ادوات مایکروویو سیلیسیمی (IMPAT ،

۵- تئوری پیوند فلز - نیمه هادی

۶- تئوری ساختار ماس (MOS)

۷- تئوری پیشرفت، ترانزیستور ماسفت

۸- الگوهای گوناگون ترانزیستور ماسفت



مراجع :

1- Physics of semiconductor Devices, shur , McGrawhill, 1990

2- Operation and Modeling of The MOS Transistor, by y .P.
Tsividis , McGraw Hill / 1988

3- Physics of semiconductor Devices, s.m.sze John Wiley, and sons , 1981

طراحي مدارهای مجتمع خطی

تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوري

پيشنياز :



سrfصل دروس : (۵۱ ساعت)

۱- اصول ساخت عناصر فعال و غير فعال

۲- مدار معادل عناصر فعال و غير فعال

۳- منابع و آينه های جريان و بررسی حساسیت آنها نسبت به پارامترهای گوناگون

۴- طراحی تقویت کننده های عملیاتی

۵- طراحی مقایسه کننده ها

۶- طراحی تقویت کننده های باند عریض

۷- طراحی مبدل های A / D D / A

۸- طراحی تقویت کننده ها با استفاده از ترانزیستورهای MOS

۹- فیلترها در مدارات مجتمع

مراجع :

- 1- Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit, by Alan, Crebene, John wiley, 1984
- 2- Analog circuit Design, J. Huijsing Kluwer, 1993
- 3- Analog mos Integrated circuits, P.R. Grag IEEE press, 1989
- 4- Linear Electronics, Bogarto merrill, 1994

ابر رسانایی ۱



تعداد واحد : ۳

نوع واحد : تئوری

پیشنبه : کوانتم الکترونیک I

سقف دسترسی : (۵۱ ساعت)

- بررسی اثرات ماکروسکوپی و تئوریهای مربوط (مقاومت صفر - هادی کامل - عمق نفوذ،...)
- عمق نفوذ در مواد خالص و غیر خالص - ابر رسانای نیم فنا فیلم نازک ابر رسانا
- نوع ابر رسانایی (کوانیتیزه کردن میدان مغناطیسی - مدل لندن مربوط به حالت مخلوط - ترانزیستور با استفاده از فلوئی ابر رسانا ...)
- بررسی میکروسکوپی (گذر به ابر رسانایی - الکترونهای آزاد در شبکه پریودیک - سطح فرمی - گاز الکترون آزاد - شکاف انرژی - ظرفیت حرارتی و اسپکتروم فنون - پخش الکترون ها توسط فنون ها - هادی کامل در مقابل ابر رسانا)
- تئوری BCS (جفت بودن الکترون - مدل زوج من - اثر متقابل الکترون - الکترون - حالت زمینی ابر رسانایی - شکاف انرژی و تحریک زوج - تئوری TC بالا)
- بدیده، تونل زنی (سد بتانسیل - سد بین فلزات معمولی - سد بین فلزات معمولی و ابر رساناهای - اتصال بین ابر رسانا و نیمه هادی و ابر رسانا ...)
- اتصال تونلی Josephson - اثرات RF (قطعه، ساخته شده از اثر تداخلی کوانتمی ابر رسانا)

مراجع -

- 1- T.Van Duzer and c.W. Turner, " principles of superconductive devices and circuits, " Edward Arnold (publishers), Ltd . Elsevier North Holland, Inc. 1981
- 2- M. Tinkham, " Introduction to superconductivity," Newyork, mcGraw - Hill, 1975
- 3- T.P. Orlando K.A . Delin , a Foundation of Applied superconductivity" Addison wesley publication company, 1990

بسمه تعالی

"مدارهای واسطه"



تعداد: ۳

نوع: نظری

پیشنایاز: میکروپروسور I

۱- پردازشگر کمکی (Co Processor)، ۸۰۸۲

- این پردازشگر ضمن اینکه از قویترین پردازشگر ریاضی موجود است رابطه خاصی با CPU دارد.
- چنانچه دانشجویان میکروپروسور ۸۰۸۶ یا ۸۰۸۸ را در درس‌های قبل نخواندند باید باشند باید الغیردد.

۲- کنترل کننده و قله:

- بعنوان نمونه می‌توان ۸۲۵۹ از خانواده اینتل توضیح داد،

- در ارتباط بین CPU و چیهای جانسی و قله از اهمیت بسیار بالاتر برخوردار است.

- در حالت گستردگی ۸۲۵۹ به صورت SLAVE و MASTER عمل می‌کند و توضیح آن اهمیت دارد.

۳- توضیح یکی از چیهای سریال (SIO):

- از خانواده زایلوج بسیار کامل است و تبادل سنکرون و آسنکرون را دارد.

- کلیمپروتکل‌های ارسال سریال که استاندارد می‌باشد باید توضیح داده شوند:

- توضیح کد SDLC, HDLC, BISYNC, MONDSYNC, CRC سایر کدهای خط؟

۴- باسهای استاندارد و مدارهای واسطه آنها:

- باسهای سریال مانند ۲۲۲ RS -

- باسهای موازی بین سیستم‌ها مانند IEEE ۴۸۸ (چیهای ۸۲۹۱ ۱۸۲۹۲ اینتل).

- باسهای موجود در یک سیستم یا BACK PLANE IEEE P896 مانند VMEL

۵- مدارهای واسطه مورداً استفاده در شبکه‌های LAN:

۶- کنترل کننده‌های CRT

- توضیح اصول کار CRT کنترولرها.

- توضیح یک نمونه از برد های کنترل CRT (غیر گرافیک).

- توضیح یک نمونه از برد های گرافیک کنترل CRT.

۷- مدارهای واسطه در اتوماسیون محیط‌های صنعتی:

- مدارهای واسطه سنسورها.

- مدارهای واسطه ارسال و دریافت سیگنال (برمحیط نویزی).



- ۸- مدارهای واسطه سیگنال‌های بیوالکتریک .
- ۹- ارتباط بین قسمت‌های مختلف دریک کامپیوتر PC :

 - ارتباط سیستم‌عامل ، BIOS و وقفه‌ها .
 - چگونگی استفاده از SLOT‌ها و باس‌های سیستم .

* توضیح : با توجه به مواد دروس پیش‌نیاز و گرایش دانشجویان هر کلاس برخی از مواد درسی فوق می‌تواند حذف و بر روى برخی دیگر تا کمی بیشتری بشود .

مراجع درس مدارهای واسطه

- 1- 8086 - 8088 AR, HITECHTURE AND PROG RAMMING , J- M TRIO -
MACMILLAN 1985
- 2 - 16 - BIT AND 32 BIT MICROPROCESSORS, AV? TAR SINGH ,
WALTER A. TRIBEL , PRENTICE- HALL INTERNATIONAL , 1989
- 3 - INTEL DATA Books
- 4- ZILOG AND Mostek DATA Books
- 5- PC SYSTEM PROGAMMING, MACHAE TISCHER , PUBLISHED BY
ABACUS , 1990

میکروپروسور ۲ (میکروپررسور پیشرفته)

تعداد : ۳

نوع واحد: نظری

بیشترین از: میکروپررسور I

۱- بررسی روش‌های طراحی ریزپردازهای ۸۰۲۸۶ و ۸۰۰۳۸۶ :

- ساختمان داخلی .

- دستورالعمل‌ها به زبان اسمبلر .

- چگونگی کارسیستم در حالت حفاظت شده (PROTECTED).

- نحوه کارسیستم در حالت چندکاره (MULT TASK).

- نحوه استفاده از حافظه ینهان (CASHE MEMORY).

۲- پردازشگرهای سیگنال دیجیتال (DSP) ;

- ویژگی‌های عمومی .

- تفاوت اساسی آنها از نظر ساختمان داخلی و نحوه اجرای دستورالعمل با پررسورهای معمولی .

- بعنوان مثال (۲۵۰۲۵) Fix POINT .

- بعنوان مثال (۲۵۰ C۶۰) TMS .

۳- ترانسپیوترها :

- اصول کلی کار آنها .

- توضیح (T - ۸۰۵) و چیهای جانبی آنها .

۴- نحوه موازی کردن میکروپررسورها :

- ویژگی میکروپررسورهایی که امکان موازی شدن دارند .

- توپولوژیهای مختلف .

- توضیح دو سیستم بعنوان مثال با استفاده از DSP ناوترانسپیوترها .

۵- پردازشگرهای لایه‌ای :

- توضیح چیهای سری XX .

- یک مثال از کاربرد آنها .

۶- کامپیوترهای RISC :

- توضیح ساختار دیسک ؟ و تفاوت آنها با پررسورهای معمولی .

-توضیح یک مثال مانند ۱۸۶ .

مراجع درس میکروپرورها ۲ (میکروپرور پیشرفته)

- 1- INTEL 80286 AND 80287 , PROGRAMMER,S REFERENCE MANUAL
1987
- 2 - 80386/ 80286 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING WILLIAM
H. MURRAY M.G.HILL 1989
- 3- 386 Microprocessor' HARDWARE REFERENCE MANUAL, INTEL,1988
- 4 - 16 Bit AND 32 BIT Microprocessors , AVTAK SINGH, WALTER
A. TRIBEL, PRENTICE - HALL INTERNATIONAL 1989
- 5 - BIT - SLICE MICROPROCESSOR DESIGN, JOHN MICK AND jtm
BRICK , M.G. HILL 1989
- 6 - TMS 320XX User,s GUIDE DIGITAL PROCESSOR PRODUCTS
DIGITAL PROCESSOR PRODUCTS, TEXAS INSTRUMENTS 1995
- 7- TRANSPUTER DATABOOKS , INM45 1994 , 1995
- 8 - MULTIPROCESSPRS, PRENTICE- HALL , DANIEL TABAK ,
INTERNATIONAL EDITIONS 1990



بررسی و کاربرد سیستم‌های موازی (PARALLEL SYSTEM)

تعداد: ۳

نوع واحد: تئوری

پیشنبه: نداشته است

امروزه استفاده از سیستم‌های موازی و پردازش موازی در صنعت و سیستم‌های سریع گسترش چشمگیری یافته است بطوریکه در سال ۱۹۹۲ حدود ۵۰٪ سوپر کامپیوترها با استفاده از سیستم‌های موازی ساخته شده‌اند و این رقم به ۷۰٪ در سال ۱۹۹۶ رسیده است. در حال حاضر نه تنها پردازش سیگنال‌های مانند تصویر، صوت، بیولکتریک، محاسبات ریاضی پیچیده "عمدتاً" با روش فوق انجام می‌شود بلکه در کنترل صنایع، پایگاه‌داده‌های سریع و موارد بسیار دیگر نیز کاربرد وسیعی پیدا کرده است. با توجه به مطالب فوق درس "سیستم‌های موازی" پیشنهادی شود که شامل دو قسمت سخت افزار و الگوریتم‌های موازی بباشد که در صورت نیاز توسط دونفر از اساتید می‌توانند تدریس گردد. البته در حال حاضر درس پردازش موازی در رشته کامپیوتر ارائه می‌شود که بیشتر جنبه آکوریتمی دارد اما همان‌طور که اشاره شد این درس ضمن اینکه به الگوریتم‌های موازی می‌پردازد بنحوه طراحی و استفاده از سیستم‌های موازی در کاربردهای مختلف رایو شن می‌دهد؛ برای دانشجویان الکترونیک مناسبترمی باشد.

۱- انواع سیستم‌های موازی:

- سیستم‌های SIMD

.(SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA) SIMD

- سیستم‌های MIMD

- سیستم‌های چند پردازنده‌ای با اتصال سست و مکمک.

- تقسیم‌بندی سیستم‌های موازی براساس تعداد پردازشگرهای

.(Array Processor) - پردازنده‌های آرایه‌ای

۲- ساختارهای موازی :

BUS ORIENTED -

MESH -

SWITCH NETWORK -

HYPERCUB - فوک مکعب



هرم PYRAMID

۳- نکات مهم در طراحی سیستم‌های موازی :

- پردازنده‌های سنکرون و غیرسنکرون

.SHARED MEMORY -

.MESSAGE PASSING -

.FAULT TOLERANCE -

- چگونگی اندازه‌گیری پرفورمانس ؟

۴- میکروپروسورهای مناسب برای پردازش موازی :

- ویزگی میکروپروسورهای مناسب .

- میکروپروسورهای باباس موازی .

- میکروپروسورهای باباس سریال (LINK).

- توضیح جنبدپرسور مناسب برای پردازش موازی مانند (TMS ۲۲۰ C۴۰, TMS ۲۲۰۲۰, TMS ۸۰۵).

- طراحی، یک یادوسیستم موازی .

□ در زیر موارد مربوط به آنکوრیتمها توضیح داده می‌شود:

۵- اشکال توازی :

.DATA PARALLELISM-

.TASK " -

.PIPELINES " -

: TASK / DATA توزیع

- توزیع استاتیک و دینامیک.

.DATA DEPENDENCY -

.LOAD BALANCING -

۶- ارتباط بین پروسورها از نظر برنامه وداده .

.PARALLEL C ۷- زبانهای برنامه‌نویسی موازی مانند

۸- چندمثال از کاربرد پردازش موازی .

- پردازش تصویر.

- پردازش صوت .



-هرم PYRAMID-

۳- نکات مهم در طراحی سیستم‌های موازی :

- پردازنده‌های سنکرون و غیرسنکرون

.SHARED MEMORY -

.MESSAGE PASSING -

.FAULT TOLERANCE -

- چگونگی اندازه‌گیری پرورمانس ؟

۴- میکروپروسورهای مناسب برای پردازش موازی :

- ویژگی میکروپروسورهای مناسب .

- میکروپروسورهای باباس موازی .

- میکروپروسورهای باباس سریال (LINK) .

- توضیح چندپروسور مناسب برای پردازش موازی مانند (TMS ۲۲۰۰، TMS ۲۲۰۰C۴۰، TMS ۲۲۰۲۰) .

- طراحی یک یادوسیستم موازی .

□ دو زیرموارد مربوط به الگوریتم‌های توضیح داده شود:

۵- اشکال توازی :

.DATA PARALLELISM-

.TASK "

.PIPELINES "

۶- توزیع : TASK / DATA

- توزیع استاتیک و دینامیک.

.DATA DEPENDENCY -

.LOAD BALANCING -

۷- ارتباط بین پروسورها از نظر برنامه و داده .

.PARALLEL C - زبان‌های برنامه‌نویسی موازی مانند

۸- چندمثال از کاربرد پردازش موازی .

- پردازش تصویر.

- پردازش صوت .

مراجع درس سیستم‌های موازی

- 1- MULTIPROCESSORS , DANIEL TABAK , PRENTICE - HALL 1990
- 2- SUPER COMPUTERS , H. STEINMANN , M.G- HILL 1991
- 3- " PARALLEL ALGORITHMS FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING COMPUTER VISION AND NEURAL NEURAL NETWORKS " , I.PITAS, JOHN WILEY & SONS 1993
- 4 - " PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTATION." , D.P. Bertsekas, J.N. Tsitsiklis, Prentice Hall 1989
- 5- Parallel Processing with the TMS 320c4x , Texas Instruments , 1994
- 6 - Transputer databooks , Inmos 1994, 1995
- 7- Parallel and Distributed Information systems , Proceedings IEEE, sep 1994
- 8- High - performance computer architecture, proceedings IEEE , jan, 1995



طراحی مدارهای الکترونیکی در فرکانس بالا

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: نظر

پیشنباز: دروس الکترونیک دوره کارشناسی

سرفصل دورس: (۵۱ ساعت)

بررسی تفصیلی اغتشاش (Noise) - مطالعه عناصر مايكروريو - تقویت کننده ها و نوسان کننده ها
با مقاومت منفی - تقویت کننده های UHF و مايكروريو - تقویت کننده های قدرت در فرکانس بالا با
بازده زیاد.

مراجع:

۱- Transistor Circuit Design Texas Instrument.

2- Tunnel Diodes

N A.Lee B.EASTER

3- Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, By
George D. Vendelin, Anthony M. Pavio, John Wiely and Sons, "1990".





تحلیل و طراحی مداره کمک کامپیوتر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیشنباز: الکترونیک آ- محاسبات عددی و ترجیحا" دانشجوی کارشناسی

ارشد

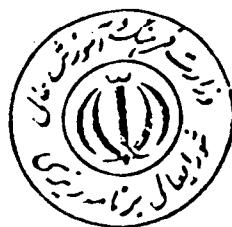
ساعدهای درس: (۵۱ ساعت)

مروری بر مفاهیم اساسی شامل عناصر مدار، دوقطبی ها، منابع وابسته، تبدیلهای تونن نرنرن، توابع شبکه، فرموله کردن گره در مدار، حل دستگاه معادلات خطی با روش حذف گون و تجزیه مثلثی، اصول ماتریس‌های اسپاین، فرموله کردن نظریه گرافی معادلات مدار، روش‌های کلی فرموله کردن شامل روش‌های تابلوئی، اصلاح شده گره گرافی‌های مجرای ولتاژ و جریان، حساسیت‌ها، حساسیت‌های چندباره‌تری، حساسیت‌های عناصر پارازتی و OPAMP روش‌های کامپیوتری تعیین حساسیت‌ها، روش سیستم محدست، ایجاد کامپیوتری توابع شبکه، تعیین قطبها و صفرهای توابع شبکه، حساسیت باتنییرات بزرگ، تحلیل نمادی توابع شبکه، روش‌های عددی انگرال‌گیری معادلات دیفرانسیل، مرتبه انگرال‌گیری خطی قطع و پایداری عددی، عکس تبدیل لاپلاس عددی مدل‌سازی عناصر الکترونیکی شامل دیود-ترانزیستور و مدل ماکروبرای DC - حل شبکه‌های غیرخطی، تعمیم آلگاریتم نیوتن راکسون: خطی کردن تکه‌ای، آلگاریتم کتزنکون - انگرال‌گیری عددی باروش‌های خطی چندگامی، انگرال‌گیری با گام و مرتبه متغیر، حس حوزه زمانی شبکه‌های غیرخطی، آشناشی با نظریه بهینه سازی،

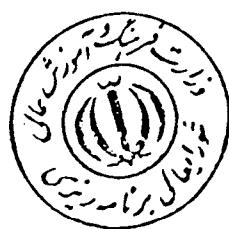
آنکاریتم اساسی تکرار و روش‌های تعیین جهت جستجو، طراحی مدار با استفاده از بهینه سازی، توابع هدف در مفهوم میانگین توان دوم، راه حل‌های مینی فاکس، می‌نیم کردن حساسیتها و تحلیل مونت کارلو و روش‌های آماری تحلیل و طراحی مدار.

مراجع:

- 1- Computer Methods for Circuit Analysis and Design by JIRI Vlach and K.Singhal van Nostrand Reinhold 1983.
۲- روش‌های کامپیوتري تحلیل و طراحی مدار ترجمه دکتر پرویز جبهه دار مارالانی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۹
- 2- Circuit Analysis, Simulation and Design, A.E.Ruehli Nolth Holland 1986.



پردازش سیگنال دیجیتال (۰۲)



تعداد واحد : ۲

نوع واحد : نظری

پیش‌نیاز : تجزیه و تحلیل سیستمها

سفرفصل دروس : (۵۱ ساعت)

مقدمه و معرفی برخی از کاربردهای پردازش سیگنال، تئوری نمونه برداری
تجزیه و تحلیل سیگنال‌های منفعل، تبدیل Z، تبدیل فوریه گستره
(FFT) و روش تبدیل فوریه سریع (DFT)، سایر
تیدیلات، تحلیل و سنتز، فیلترهای FIR، تحلیل و نتزرفیلترهای
IIR، اثرات کوانتیزه بودن در فیلترهای دیجیتال.

مراجع :

A.V. Oppenheim and R.W. Schafer, "Discrete Time
Signal Processing". Prentice-Hall 1989.

ربا فیات مهندسی پیشرفت

۱۰

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : نظری

پیشناز : ربا فی مهندسی دوره کارشناسی
هدف : این درس برای تکمیل اطلاعات پایه ریاضی
دانشجویان کارشناسی ارشد پیش‌بینی شده است.

سرفصل دروس : (۵۱ ساعت)

سرفصلهای این درس با توجه به گرایش خاصی که
دانشجویان هر دانشکده خواهند کرفت توسط کمیته کارشناسی ارشد
آن دانشکده تعیین می‌گردد.

برای منال سرفصلهای زیر پیشنهاد می‌شود که قسمتهایی
از آن میتوانند مورد استفاده قرار گیرد.

جبر ماتریسی - حل عددی معادلات دیفرانسیل برای
مشتقات نسبی - حل عددی معادلات انتگرال - مسائل مقدار مرزی
از نقطه نظر عددی - انتگرال و تبدیل فوریه پیشرفت و تبدیل
لابلاس پیشرفت - تبدیلات Z - DFT & FFT - حساب تغییرات -
معادلات انتگرال - احتمالات - متغیرهای تمازنی - فرآیندهای
تمازی - تئوری پیشرفت توابع مختلط - حل معادلات دیفرانسیل
جزئی.



